PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-038209

(43) Date of publication of application: 08.02.1989

(51)Int.Cl.

B28D 5/00

H01L 21/78

(21)Application number: 62-195571

(22)Date of filing:

04.08.1987

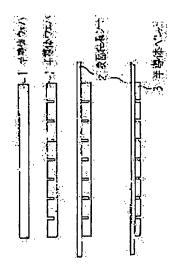
(71)Applicant: NEC CORP

(72)Inventor: IKEDA FUMIMARO

(54) PREPARATION OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform good cutting without damaging a pellet, by dicing a semiconductive wafer along the scribing line of one main surface thereof to provide a cut groove and subsequently bonding an adhesive sheet to the main surface of the semiconductive wafer before grinding the other main surface of the semiconductive wafer to divide said wafer into semiconductive pellets. CONSTITUTION: The wafer 1 is diced along the scribing line of one main surface thereof before the grinding of the back surface of the wafer 1 is performed to provide a cut groove. Next, a surface adhesive sheet 2 is bonded to one main surface of the wafer to fix and hold said wafer 1 to the surface adhesive sheet 2. Subsequently, the other main surface (back surface) of the wafer 1 is ground so as to reach the cut groove provided by dicing to divide the wafer 1 into indivisual pellets 3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

昭64-38209

[®] 公開特許公報(A)

⑤Int.Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)2月8日

B 28 D 5/00 H 01 L 21/78 Z-7366-3C Q-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体装置の製造方法

②特 願 昭62-195571

四出 願 昭62(1987)8月4日

⑩発明者 池田 史麻呂

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

20代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細管

1. 発明の名称

半導体装置の製造方法

2 特許請求の範囲

半海体ウェハを個々の半導体ペレットに分割する工程を備えた半導体装置の製造方法に於て、前配半導体ウェハの一主製面のスクライブラインに沿ってダイシングを行い切濘を設けた後、前配半導体ウェハの一主製面に粘層シートを貼付け、次に前配半導体ウェハの他主製面を研削することを特徴とする半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置の製造方法に係り、特に半 導体ウエハを個々の半導体ペレットに分割する方 法に関する。

〔従来の技術〕

従来の学導体ウェハの分割方法を、第3図(a)及 至第3図(b)の関面図に示す。通信、半導体ウェハ (以下単にウェハと配す)は、個々の半導体は ット(以下単にペレットと配す)に分割される前 の工程で、ウェハ厚を規定の寸法とする為に、ウ エハ浸面の研削を行なっている。同図(a)では、更 うに、このウェハ1の裏面を研削するととにより 別定の寸法の関(c)に示すように、ウェハ1の裏 面を設面粘層シート4に出付け、固定保持する。 しかるのちに、同図(d)のごとく、ダイシングにより り裏面粘着シート4の一部まで切り込み、個々の ペレット3に分割していた。

[発明が解決しようとする問題点]

前述した従来のウェハの分割方法は、粘着シート4に貼付けられたウェハ1を、完全に個々のペレットに分割するために、粘着シート4の一部まで切込む必要がある。この方法では、ダイシング

に使用されるプレードは、粘着シート4を切込ん だ時に、消耗量が、急激に増加することがわかっ ている。このため、プレードの交換頻度が頻繁に なっている。

また、粘着シート 4 表面に塗布された粘着剤を、 ウェハ1 のダイシングと同時に切削する為、粘着 剤を巻き上げ、ペレットの表面に粘着剤が付着し ペレットに悪影響を与える。同時に、ダイシング 途中で切りはなされたウェハ1 の個片が、ダイシ ング時のストレス及び、粘着シート 4 の伸縮によ り位置ずれをおこし、スクライブラインに対して カッティングラインがずれ、カッティング精度が 低下する。

本発明の目的は、前記問題点を解決し、プレードの消耗量を減少させ、ペレットをそこなう必配もなく、良好にカッティングができるようにした 半導体装置の製造方法を提供することにある。

〔 問題点を解決するための手段〕

本発明の構成は、半導体ウエハを個々の半導体 ペレットに分割する工程を備えた半導体装置の製

3 に分割する。

第2図(a)乃至第2図(e)は本発明の第2の実施例 の半導体装置の製造方法を工程順に示す側面図で ある。まず第1図(2)において、裏面研削を行なり 前のウェハ1を用意し、第1図(b)に於て、裏面粘 着シート4をエエハ1の他主表面(裏面)に貼付 る。との状態で、ウエハ1のダイシングを行ない 切溝を設けると、第1図(c)のようになる。次に餌 1 図(d)のどとく、ウェハの一主表面(表面)に表 面粘着シート2を貼付け、その次に裏面粘着シー ト 4 をはがす。その後、ウエハ1の裏面を研削す ることにより、第1図(e)に示すように、個々のペ レット3に分割する。本実施例では、ダイシング でウェハ1に切得を設ける工程からウェハ1の一 主表面に表面粘着シート2を貼付ける工程までに、 ダイシングによる切簿でたとえウエハが割れても 裏面粘着シート4上に保持されている為、ウエハ 1の破損による廃棄をしなくてもよいといり利点 がある。

[発明の効果]

造方法に於て、前配半導体ウェハの一主表面のスクライプラインに沿ってダイシングを行い、切隣を設けた後、前配半導体ウェハの主表面に粘滑シートを貼付け、次に前配半導体ウェハの他主表面を研削することにより前配個々の半導体ペレットに分割することを特徴とする。

〔 與施例〕

次に本発明について図面を参照して詳細に説明

第1図(a)乃至第1図(d)は本発明の第1の実施例の半導体装置の製造方法を工程順に示す偶面図である。まず第1図(a)にかいて、裏面研削を行なり前のウェハ1があり、第1図(b)に示すごとく、ウェハ1の一主表面のスクライブラインにそってダイシングを行い、切構を設ける。次に第1図(c)に於て、ウェハ1の一主表面に表面粘着シート2を貼付け、ウェハ1を表面粘着シート2に固定保持する。次に第1図(d)に於て、ウェハ1の他の主表面(裏面)を、前配ダイシングによって設けられた切潰まで研削することにより、個々のベレット

以上説明したように、本発明は、ダインング時に粘剤シートまでも切込むことがなく、個々のペレットに分割することが容易となり、よってダインング時に使用されるブレードの消耗量が少なくてすみ、また粘剤シートを切込むことに起因する粘剤剤の巻き上げによるペレット姿面への付着がなくなり、さらにダインング油中でのウェハ個片のずれがなくなり、ダインング精度を維持可能となり、スクライブラインに対するカッティングラインのずれがなくなるという効果がある。

4 図面の簡単な説明

第1図(a)乃至第1図(d)は本発明の第1の突施例の半導体装置の製造方法を工程順に示す側面図、第2図(a)乃至第2図(e)は本発明の第2の実施例の半導体装置の製造方法を工程順に示す側面図、第3図(a)乃至第3図(d)は従来の半導体ウェハの分割方法を工程順に示す側面図である。

1.1……半導体ウエハ、2……表面粘着シー

特開昭64-38209(3)

